

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 62-013120
 (43)Date of publication of application : 21.01.1987

(51)Int.CI.

H03K 19/00
 H01L 27/08
 H03K 17/687
 H03K 19/094

(21)Application number : 60-153433

(71)Applicant : MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing : 10.07.1985

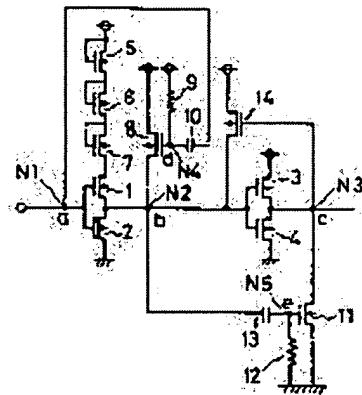
(72)Inventor : KIHARA YUJI

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To realize a semiconductor device with low power consumption by providing a voltage drop series transistor (TR) decreasing the power voltage of the 1st input stage and a capacitance coupling circuit to prevent operation delay.

CONSTITUTION: A voltage of a TR lower by $1V_{THN}$ is obtained at the drain of N-channel TRs 5, 6, 7. A voltage of VCC (power voltage)- $3V_{THN}$ is applied to the drain of the N-channel TR 7 by using the three TRs. The circuit consisting of TRs 8, 11, resistors 9, 12 and capacitors 10, 13 is to prevent the operation delay and the gate of the TRs 8, 11 is fixed by the resistors 9, 12 so as not to give any effect in terms of DC and the circuit prevents the operation delay only when the input voltage level changes from H to L.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)

(11) Publication number:

62013120 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN(21) Application number: **60153433**(51) Intl. Cl.: **H03K 19/00 H01L 27/08 H03K 17/687 H03K 19/094**(22) Application date: **10.07.85**

(30) Priority:

(43) Date of application
publication: **21.01.87**(84) Designated contracting
states:(71) Applicant: **MITSUBISHI ELECTRIC CORP**(72) Inventor: **KIHARA YUJI**

(74) Representative:

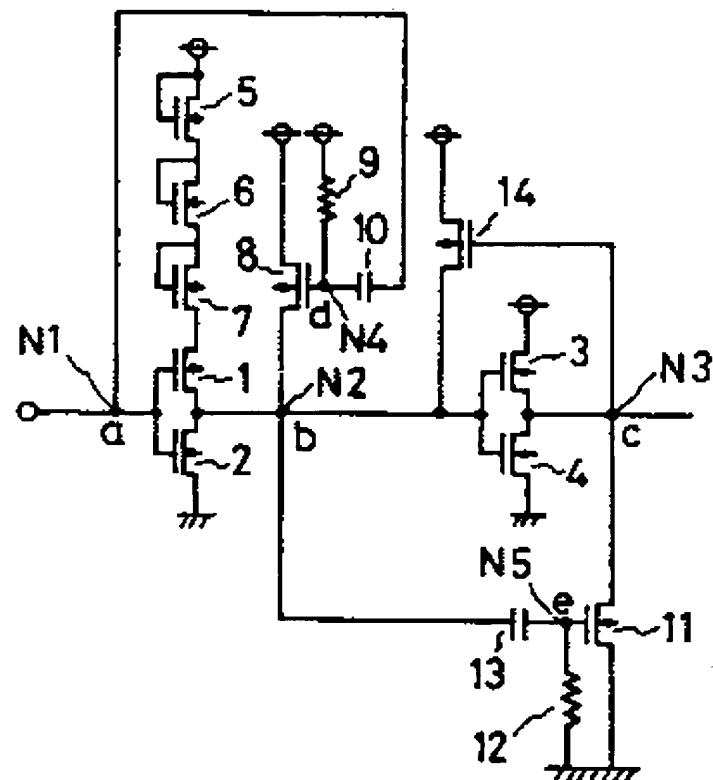
**(54) SEMICONDUCTOR
DEVICE**

(57) Abstract:

PURPOSE: To realize a semiconductor device with low power consumption by providing a voltage drop series transistor (TR) decreasing the power voltage of the 1st input stage and a capacitance coupling circuit to prevent operation delay.

CONSTITUTION: A voltage of a TR lower by $1V_{THN}$ is obtained at the drain of N-channel TRs 5, 6, 7. A voltage of V_{CC} (power voltage)- $3V_{THN}$ is applied to the drain of the N-channel TR 7 by using the three TRs. The circuit consisting of TRs 8, 11, resistors 9, 12 and capacitors 10, 13 is to prevent the operation delay and the gate of the TRs 8, 11 is fixed by the resistors 9, 12 so as not to give any effect in terms of DC and the circuit prevents the operation delay only when the input voltage level changes from H to L.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio



⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公告
 ⑪ 特許公報 (B2) 昭62-13120

⑤Int.Cl.
 B 23 K 26/06
 26/08
 H 01 S 3/00

識別記号 庁内整理番号
 7362-4E
 7362-4E
 6466-5F

⑫公告 昭和62年(1987)3月24日
 発明の数 1 (全3頁)

⑬発明の名称 ガルバノメータ光走査型レーザ加工装置

⑭特 願 昭57-87471
 ⑮公 開 昭58-205690
 ⑯出 願 昭57(1982)5月24日 ⑰昭58(1983)11月30日

⑭発明者 井上廣治 東京都港区芝五丁目33番1号 日本電気株式会社内
 ⑮出願人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号
 ⑯代理人 弁理士内原晋
 ⑰審査官 沼沢幸雄

1

2

⑬特許請求の範囲

1 ムービングコイル型ガルバノメータの回転軸上に取り付けられた反射鏡を位置信号によって回転させ反射鏡に入射したレーザ光の反射光を移動させて加工を行うガルバノメータ光走査型レーザ加工装置において、互に直交する1対のガルバノメータと、このガルバノメータへ入射する前にレーザ光が通過し、レーザビーム径を拡大するレーザビームエクスパンダーとを含み、このレーザビームエキスパンダを構成する少なくとも1つのレンズの光軸がレンズの中心軸に対して極少量偏心させかつ中心軸のまわりに高速に回転させる駆動機構を附加したことを特徴とするガルバノメータ光走査型レーザ加工装置。

発明の詳細な説明

本発明はガルバノメータ光走査型レーザ加工装置に関するものである。

レーザビームを二次元に移動させることはレーザ加工などの応用に不可欠な技術である。ガルバノメータの回転軸上に取り付けられた反射鏡の回転を利用して、レーザ光を二次元に走査する方法は、立上りの加速度数10G、移動速度数m/秒が容易に得られ極めて高速の加工が可能である特徴を持っている。レーザ加工装置の内でも高速性の要求される厚膜ハイブリッドICや抵抗モジュールのトリミング装置や試料に英数字等などを印字するレーザマーキング装置などの応用には、この方法が広く応用されている。

こうしたガルバノメータ方式の加工装置の加工

幅はレーザビームの集光径できまり、通常 $50\mu m$ 程度であるが、最近より広い加工幅の加工幅も要求される事例が多くなっている。たとえばレーザトリミングの場合では高圧回路に使用するハイブリットICでは耐圧が要求されるため切り込みの幅が広いことを必要とする。またレーザマーキングでは商標やタイトルなどに太くて鮮明な文字への需要は大きい。

加工幅を広くする為には、レーザビームのスポット径を大きくすることが簡単には考えられるがスポット径を大きくすることにより、パワー密度が低下し、加工能力が低下し、抵抗が十分切断されない、あるいは文字が不鮮明になるという欠点があつた。したがつて細いスポット径のまで太い加工幅が得られる加工装置が求められていた。

本発明の目的は、このような要求に沿つた細いスポット径のまで太い加工幅が得られるガルバノメータ光走査型レーザ加工装置を提供することである。

20 本発明によれば、ムービングコイル型ガルバノメータの回転軸上に取り付けられた反射鏡を位置信号によって回転させ反射鏡に入射したレーザ光の反射光を移動させて加工を行うガルバノメータ光走査型レーザ加工装置において互に直交する1対のガルバノメータとこのガルバノメータへ入射する前にレーザ光が通過し、レーザビーム径を拡大するレーザビームエクスパンダーとを含み、このレーザビームエキスパンダを構成するレンズの少なくとも1つのレンズの光軸がレンズの中心軸

に対して極小量偏心させ、かつ、このレンズを中心軸のまわりに高速に回転させる駆動機構を附加したことを特徴とするガルバノメータ光走査型レーザ加工装置が得られる。

次に本発明について図面を参照しながら詳細に説明する。第1図は本発明のビームエキスパンダ部分の一実施例で原理を説明するための図である。レンズ1は光軸と中心軸が偏心しており、レンズ1の中心軸のまわりの回転によりこれを通過するレーザビームは軌跡が曲げられ円運動を行ない、ビームエキスパンダのもう1つのレンズ2を通して後も微小な円の軌跡3を描く。このように微小な偏心させたレンズを高速回転させることによって、これを通過したレーザビームは微小の円運動を伴つており、このレーザ光をガルバノメータで走査することによって得られる加工の軌跡は第2図のように模式的に示される。このようにすることにより広い加工幅が得られると同時に円運動であるため進行方向に往復する成分があるため偏心量を適度にとることにより、レーザ光の軌跡の開始点と終端点の近傍を除き、レーザ光の照射がくり返して照射することが可能である。このくり返し照射のためレーザの加工特性が向上する。第3図は本発明の一実施例である。

レーザ発振器11から発射されたレーザビームは偏心レンズを含み回転駆動機構13により高速回転させられているビームエキスパンダ12を通過し、円運動を行う。円運動を行うレーザビームは、X軸ガルバノメータ14およびY軸ガルバノ

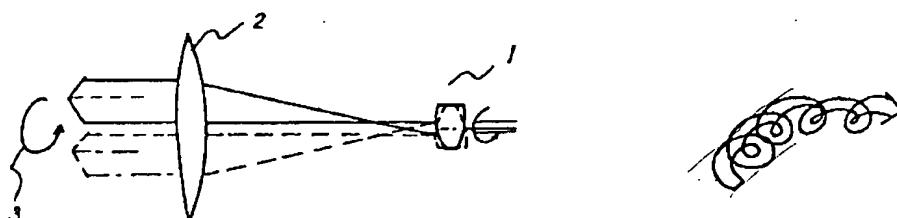
メータ15により高速のビーム移動が行われ対物レンズ16および90°反射鏡17を経て試料18に照射される。19, 20はそれぞれガルバノメータの位置信号および駆動回路である。偏心レンズの回転を止めればもとの細い加工幅も得られる。偏心レンズの偏心量レンズの曲率等によって円運動の径は適当に設定できる。また、回転させる偏心レンズはエキスパンダを構成するどのレンズでもよい。また、回転させるレンズは1つのレンズに限るものではなく複数のレンズを回転させても加工の軌跡は複雑になるが同様の効果を生むことが可能である。

このように本発明によれば、レーザスポット径より大きな加工幅が得られかつ優れた加工特性を15持つガルバノメータ光走査型レーザ加工装置が得られる。

図面の簡単な説明

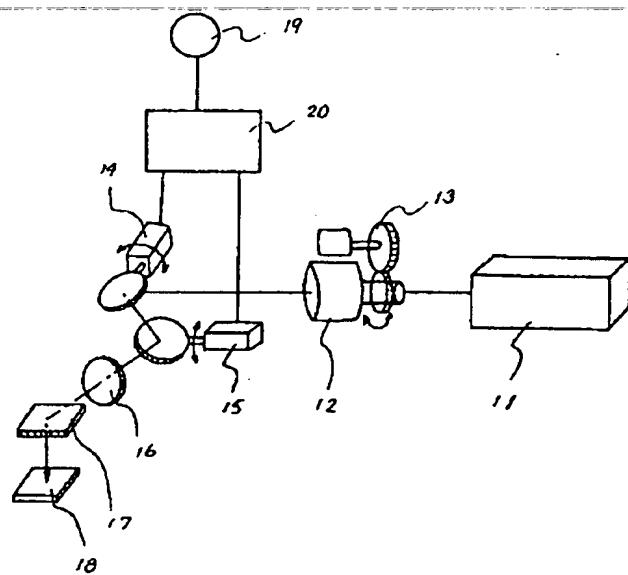
第1図は本発明の原理を示すためのビームエキスパンダ部の一実施例、第2図は本発明による加工軌跡の模式図であり、第3図は本発明の一実施例を示すガルバノメータ光走査型レーザ加工装置の構成例である。

1, 2はレンズ、3はビームの動き、11はレーザ発振器、12はビームエキスパンダ、13は回転駆動機構、14, 15はガルバノメータ、16は対物レンズ、17は90°反射鏡、18は試料、19, 20はガルバノメータの位置信号と駆動回路である。



第1図

第2図



第3図